$$\sigma = \frac{\Delta P}{P} = \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta Q}{Q}\right)^2 + \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2 + \left[\frac{\Delta \left(\frac{dE}{dT}\right)}{\left(\frac{dE}{dT}\right)}\right]^2 + \left(\frac{\Delta P_{\text{KE}}}{P_{\text{GE}}}\right)^2}$$

 $= \pm \sqrt{(0.3\%)^2 + (0.7\%)^2 + (0.5\%)^2 + (0.5\%)^2} \approx \pm 1\%$ 取极限误差 Δ=3σ 则 △= ±3% 也就是说我们的流水功率计的不可靠性

在±3%以内。我们用它与标准绝对辐射计 的数次比对以及与标准中功率计的比对也都 符合在这一范围,因而也证实了这一结论。

金属膜滤光片反射相移的自动补偿

尹 树 百

提 要

本文研究了制备滤光片的简捷控制方法——直接法的应用范围,指出它不仅适 用于介质膜系,也适用于吸收膜(金属膜)系。从实验上已证实[1],用此法控制膜厚, 可使金属膜与介质膜之间的界面反射相移自行补偿,从而提高了滤光片的主峰波长 定位精度。

- 引 言

窄带干涉滤光片的镀制, 是光学薄膜技 术中较困难的课题。其中心问题是透射主峰 波长的精确定位,即要求所镀滤光片的最大 透射率(主峰)准确地重复出现在预期波长 处。因此,必须精确控制膜层的光学常数(n) 及其厚度(t)。为了提高每层膜的控制精度, 曾提出了光电极值法、波长扫描法、双色法、 分光曲线比较法、晶体频移法等等。 直接控 制法则是对滤光片本身直接进行膜厚控制 (不用间测监控片),此时相邻各层膜的厚度 必然相关,其厚度误差能相互自行补偿。对 于全介质膜系而言,采用直接法,即使每层膜 厚度用控制精度不太高的极值法进行控制, 亦能得到主峰定位精度很高的滤光片。这一

点已为许多作者[7,8]从理论与实验上加以证 实。

然而,对于介质膜系适用的直接控制法 能否推广用来控制金属膜(有强吸收)滤光 片?在制备紫外金属膜滤光片时,我们作了尝 试^[1],取得了预期的效果,此方法不但简便易 行,而且提高了主峰波长的定位精度。

对于金属膜滤光片的制造,通用的方 法[2~5] 是每层膜均单独用一块新的监控片进 行厚度控制(间接法)。这样给制造上带来很 多麻烦,不但要有间测片的换片机构,而且由 于金属膜与间隔层分界面的反射相移(与全 介质膜系不同),既不为零,也不为π;而是 0~π中间的某一值。从而使间隔层厚度的 确定发生困难,因为反射相移的影响,其值不 再简单地为 $\frac{\lambda_0}{2}$ 的整数倍, λ_0 为滤光片主峰

· 26 ·

波长。此外,作间接测量用的监控片与工件 (滤光片本身)的相互位置,必须精确固定,否 则也会引起膜厚误差。更主要的是在新鲜监 控片上与在已有镀层的工件上,继后的膜层 的凝结状态是大不相同的,从而带来很难修 正的膜厚误差。事实上,在真空镀膜过程中, 膜层凝结状态与许多因素有关,而这些因素 却又很难控制到每次均重复一致。

采用作者提出的方法⁽¹¹⁾,对滤光片的每 层膜自始至终直接进行控制,则可以不必考 虑所用膜料的光学常数随蒸发条件的变化, 而间隔层厚度会与金属膜界面的反射相移自 行得到补偿,从而(与间接控制法比较)提高 了滤光片主峰波长的定位精度。

二、方法分析

根据滤光片的透射率公式:

$$T = \frac{T_1 T_2}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})^2} \cdot \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{1}{2} Y} \quad (1)$$

不难求出透射率极值 $\tau_{max} = \tau_{mino}$ 式中 T_1 、 T_2 、 R_1 、 R_2 分别为金属反射膜 $M_1 = M_2$ 的 透射率和反射率(见图 1)。



图1 滤光片的剖面示意图

$$F = 4(R_1R_2)^{2/2} / [1 - (R_1R_2)^{2/2}]^2$$
$$Y = 2\psi - (\phi_1 + \phi_2) + (\delta_1 + \delta_2)$$
(2)

其中 ϕ_1 、 ϕ_2 与 δ_1 、 δ_2 分别为 M_1 与 M_2 的反 射相移和透射相移(在一级近似下,可忽略透 射相移的影响); $\psi = 2\pi/\lambda \cdot nt \cos\theta$ 为间隔层 的相位厚度。在垂直入射下, $\cos \theta = 1$,这并 不失去普遍性。

不难看出,当 Y 为零或 2π 的整数倍时, 便得到滤光片的透射率极大值,即当

$$Y = 2\psi - (\phi_1 + \phi_2) + (\delta_1 + \delta_2) = 2m\pi$$

(3)

$$m=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$$

时,便得

$$\tau_{\max} = \frac{T_1 T_2}{[1 - (R_1 R_2)^{1/2}]^2}$$
(4)

由公式(3)还可求出, m 干涉级次的主峰波 长 λ^(m)

$$\lambda^{(m)} = \frac{2mt}{m + (\phi_1 + \phi_2)/2\pi} \tag{5}$$

此外也求得通带半宽度 ω₀.5:

$$\omega_{0.5} = \frac{(1-R)\lambda^{(m)}}{\pi R^{1/2} \left[m - \frac{\phi}{\pi} - \frac{\lambda^{(m)}}{\pi} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} \right]} \quad (6)$$

上式中已引入高反射金属膜的平均反射率 R,和相移φ。假定金属膜 M₁与 M₂完全对称,则有

$$T = \sqrt{T_1 T_2}, \quad R = \sqrt{R_1 R_2},$$
$$\phi = \frac{1}{2} (\phi_1 + \phi_2)$$

又因 R+T+A=1, 故得

$$T_{\max} = \frac{T^2}{(1-R)^2} = \frac{1}{(1+A/T)^2}$$
 (7)

$$\lambda^{(m)} = \frac{2nt}{m + /\phi\pi} \tag{8}$$

公式(6)中分母的最后一项为反射相移色散 (通常被忽略了)。

由公式(8)可看出,最大透射率所在波长 λ^(m)(主峰位置)不仅与间隔层的光学厚度 (nt)有关,而且决定于间隔层与高反射金属 膜间界面的反射相移(严格地说,还与透射相 移以及相移色散有关)。假定反射相移在通 带区内为常数,并假定半透明金属膜的光学 常数与其厚度关系甚微,则可由下式求得反 射相移值:

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{2nK_1}{n^2 - n_1^2 - K_1^2} \right) \tag{9}$$

. 27

n为间隔层折射率, 对氟化镁 膜而言, n≈

1.39。 $n_1 = n_1 - iK_1$ 为金属膜的光学常数 (也称复折射率)。上式给出的 ϕ 值,实际上 为不透明金属膜界面的反射相移。对于铝膜 来说,其在紫外区的光学常数与蒸镀条件密 切相关^[71],故应根据各人所镀膜层进行实 际测量而求得 $n_1 = n_2$ 。我们未能实测,仅 援引哈斯等^[10]的数据进行计算。由于 $n = K_1$ 始终是正数,因此,由公式(9)求得的 ϕ 值 将在第一与第二象限内,所以,代入公式(8) 中的主值将在 $0 \sim \pi$ 之间。 ϕ 的数值表明,主 峰波长将从间隔层光学厚度为 $\frac{\lambda^{(m)}}{2}$ 的位置 向短波方面移动。移动的波长数值可根据公式(9)与(8)计算出来。

三、控制过程

在制造金属膜滤光片时,应首先根据所 需透射率值 τ_{max} ,确定满足公式(4)的 T_1 、 R_1 与 T_2 、 R_2 ,然后可确定具有规定 R_1 、 T_1 值的 M_1 膜与 R_2 、 T_2 值的 M_2 膜的厚度。假设两 金属膜 M_1 与 M_2 完全一致,则可由下述方 程求得不同厚度的金属膜的反射率R与透 射率 T^{cun} .

$$R = \frac{(g_1^2 + h_1^2) e^{2\alpha_1} + (g_2^2 + h_2^2) e^{-2\alpha_1} + a \cos 2\beta_1 + b \sin 2\beta_1}{e^{2\alpha_1} + (g_1^2 + h_1^2) (g_2^2 + h_2^2) e^{-2\alpha_1} + c \cos 2\beta_1 + d \sin 2\beta_1}$$
(10)

$$T = \frac{n_s}{n_0} \cdot \frac{[(1+g_1)^2 + h_1^2] [(1+g_2)^2 + h_2^2]}{e^{2\alpha_1} + (g_1^2 + h_1^2) (g_2^2 + h_2^2) e^{-2\alpha_1} + c \cos 2\beta_1 + d \sin 2\beta_1}$$
(11)

式中

$$a = 2(g_1g_2 + h_1h_2)$$

$$b = 2(g_1h_2 - g_2h_1)$$

$$c = 2(g_1g_2 - h_1h_2)$$

$$d = 2(g_1h_2 + g_2h_1)$$

$$g_1 = \frac{n_0^2 - n_1^2 - K_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + K_1^2}$$

$$g_2 = \frac{n_1^2 - n_s^2 - K_1^2}{(n_1 + n_s)^2 + K_1^2}$$

$$h_1 = \frac{2n_0K_1}{(n_0 + n_1)^2 + K_1^2}$$

$$h_2 = \frac{2n_sK_1}{(n_1 + n_s)^2 + K_1^2}$$

 $g_1, g_2 与 h_1, h_2$ 称为菲涅耳系数,其中 $n_1 = n_1 - iK_1$ 为铝膜光学常数; n_s 为基片折射率。 n_0 为入射媒质(通常为空气,在此为氟化镁 膜)的折射率; α_1, β_1 为铝膜的相位厚度的 虚部与实部;由下式确定:

$$\alpha_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot K_1 t_1, \quad \beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot n_1 t_1 \quad (12)$$

根据所要求的 铝膜厚度 (约 200~300 埃),算出铝膜的 T 或 R 后,便可在透明基片 (通常为石英玻璃)上镀出有规定透射率 T 或 反射率 R 的铝膜。然后,镀一层适当厚度的 介质膜(MgF₂),使界面反射相移被抵消,即 相当于镀一层内增透膜,其厚度应满足增透 条件:

$$nt = \frac{\lambda_0^{(m)}}{4\pi} \cdot \phi \tag{13}$$

紧接着按所要求的干涉级次(m),镀 m 个半 波长厚度的介质膜(MgF₂)。最后,应继续镀 一层厚度满足方程(13)的介质膜(MgF₂),前 提是在两金属反射膜 M₁ 与 M₂ 完全一致的 条件下。紧接着镀一层铝膜 M₂,则得到了滤 光片。此时其通带业已形成,如要制造多半 波滤光片,则应按上述方式继续镀下去。

对于远紫外区使用的滤光片,由于铝膜 会遭氧化而性能变坏,故应在镀完最后一层 铝膜之后,迅速镀一层满足公式(13)的保护 膜(MgF₂)。这层膜既有保护作用,又起增透 效果。

为使直接法发挥最佳效果,必须用滤光 片的主峰波长作控制波长,并且当透射率或 反射率(均随膜厚而变化)达极值时停镀。例 如,要制造λ₀=2200 埃的滤光片,便应用波 长 2200 埃的单色光进行膜厚控制。且单色 性要足够好,强度应足够稳定,故以激光器 或线状光谱灯作光源为佳,也可用紫外单色 器。用紫外灵敏的光电元件为接收器,用检 流计或函数记录仪显示(见表1)。

膜 层	相对读数	备 注		
Al	$145 \sim 35$	第一高反射膜		
	90~132	前反射相移补偿层		
MgF ₂	132~90~131~89~130	二级次间隔层		
	130~91	后反射相移补偿层		
Al	80~118	第二高反射膜		
Al	145~35	高反射镜		
MgF_2	90~130~89~131~91	前后反射相移补偿 层和一级次间隔层		
Al ,	80~120	高反射镜		
MgF ₂	100~118	增透保护膜		

表1 镀膜过程的显示(λ₀=2200 埃)

如果缺乏适用的紫外单色光源和接收 器,则可通过上述公式进行计算⁽¹¹⁾,求出适当 的控制波长 λ ,以制出 λ_0 的滤光片。亦可用 次级低的干涉次峰波长控制高级次的主峰 波长的滤光片,即用长波控制短波区的滤光 片。例如,我们曾用 λ_1 =4150埃与 λ_2 =6750 埃的单色光进行膜厚控制,制成了主峰在 λ_0 =2200埃的二级次与三级次紫外滤光片 (见表2)。根据滤光片理论, λ_1 应为 λ_0 的两 倍, λ_2 应为 λ_0 的三倍,然而由于相移色散等

膜 层	控制波长	读	数	备	注
Al	λ1=4150 埃	145~28		前反射镜	
MgF_2	λι	90~134	4.4~92	前后补偿层与间隔层	
Al	λ1	50~4	7~95	后反射镜	
MgF_{2}	λ1	90~9	4	保护用的增透层	
Al	λ2=6750 埃	145~:	29	前反射镜	Ĵ
MgF_2	λ_2	90~1	32~89	前后补偿隔层	《层与间
Al	λ_2 .	85~1	46	后反射镜	Ì
MgF_2	λ_2	68~7	5	保护用的	的增透膜

表2 镀膜控制过程示范(λ₀=2200 埃)

的影响,故作了相应修正。当后反射镜镀完 后,通带业已形成。

四、结语与讨论

作者所提出的方法^[11],由于直接控制连 续各层膜的镀膜,使得金属膜与介质膜间隔 层界面的反射相移得到了补偿(最近国外有 类似我们所提方法的文章报导^[121]),因此,虽 然因蒸发条件和操作技巧不同,使得每次所 镀铝膜的光学常数与厚度不尽相符,从而使 反射相移 \phi 有所差异;但由于紧接着的氟化 镁是直接镀在铝膜上面的,且根据工件本身 来控制,故彼此是相关的, \phi 的变化则通过氟 化镁膜来补偿。故减少了总的误差,正如[1] 所证明的,提高了主峰波长定位精度。

然而,为得到优质的紫外金属膜滤光片, 除必须尽快地将高纯铝蒸镀在冷基片上,并 使各层膜的蒸发速率保持恒定外, 还必须对 个别层膜厚有更精确的控制,尤其是后反射 镜的极大值点的精确控制。因为由于间隔层 未镀够,后反射膜可予以补偿(见表2)。但 当后反射膜过厚,则其透射率越过极值点而 向减小方向运动,因而大大降低了滤光片的 总透射率,且使主峰有所偏离。如果过头尚 不多,则可用最后一层增透膜进行补救。例 如,我们镀过这样的滤光片(表3),虽然后反 射膜过厚,回头了25格,但仍得到较满意的 结果: 控制波长为 4250 埃, 二级次主峰在 2240 埃处, 主峰透射率为 41%, 半宽度为 240 埃。但是,如果整个膜系用直接法控制, 而个别膜层厚度用带补偿机构的极值法或波 长扫描法[13] 配合控制,则可进一步提高主峰 定位精度。

其次,应尽可能用主峰波长 λ₀ 来进行控制,才能充分发挥本方法的直观与简便这一 优点。这样一来,便可不考虑膜层的光学常 数具体数值。若条件允许,则最好能对自己 实际所镀膜层进行就地测量,以得到一定蒸

膜 层	相对读数	备注	
Al	145~33	前反射镜	
MgF ₂	90~130~91	间隔层	
Al	60~55~100~75	后反射镜	
MgF_2	80~91	增透保护层	

表3 镀膜过程显示

镀条件下的光学常数值,然后代入上述公式 计算,求出适当的相应控制波长,最后用直 接法进行控制。我们是按哈斯^[10]给出的数据 进行计算的。并根据镀膜机与控制系统等具 体条件的不同,作了修正。

本方法所制成的紫外滤光片,与其他方 法的制成品一样^[2~4],其性能会随时间稍有 变化,大约一周后方趋于稳定。这主要也许 是膜层间相互渗透扩散以及吸附气体所致。

本方法可用于任何波段,只要有适当的 单色光源和相应的探测器。其最大优点是简 便、直观,且主峰定位精度比间接法控制有明

显的提高。

参考资料

- [1] 尹树百等, 《光学工程》, 1976, No. 4, 1。
- [2] D. J. Schroed; JOSA, 1962, 52, 1380
- [3] B. Anders et al.; Appl. Opt., 1966, 5, 971.
- [4] D. H. Harrison; Appl. Opt., 1968, 7, 210.
- [5] H. Anders et al.; Optik, 1974, 40, No. 3, 358.
- [6] G. Baldini et al.; Thin Solid Films, 1972, 13 143.
- [7] Ш. А. Фуран; ОМП, 1968, № 9, 54; 1967, № 1, 39.
- [8] P. Bousguet; Thin Solid Films, 1972, 13, 285.
- [9] H. Anders; Dünne Schichten für die Optik, p. 94, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart(1965).
- [10] D. E. Gray Co. Ed., American Institute of Physics Handbook, p. 6~107, McGraw-Hill Book Company, Inc. (1963), N. Y.
- [11] O.S.希文斯,《固体薄膜的光学性质》,第四章,尹 树百译,国防工业出版社(1965).
- [12] R. Arsenault et al.; Appl. Opt., 1977, 16, No. 7, 1890.
- [13] 钟秀清,朱震;《激光与红外》,1976, No. 4, 1.

拉晶转速的程控与测量

中国科学院上海光机所十二室自控组

随着温度自动控制仪表的广泛使用, Nd:YAG、YAP 晶体质量有了较大提高。但 是,要使整根晶体都保持良好的光学质量仍 存在一定的困难。这是由于在引上法生长激 光晶体时,晶体转速的稳定直接影响晶体质 量。为了保持固一液界面平坦,还需要在拉 晶过程中使晶体转速在一定范围内缓慢变 化。根据我所的实践,在~90转/分的恒定 转速下,Nd:YAG、YAP 晶体生长的固一液 界面往往经历由凸到平、到凹的变化。而在 凸和凹的固一液界面中不能得到光学均匀性 良好的晶体。故采用变转速生长,即开始以 80~100转/分下晶种,然后逐渐降慢转速, 至拉晶结束时为 30~50 转/分。这样便可以 获得整根晶体基本上是平坦的 生长 面。"转 速程控-测量仪"不仅能控制晶体转速稳定, 而且可以根据需要按所要求的一定程序来改 变转速,并随时测量转速。可见本仪器在引 上法生长工艺中是十分有价值的^(1,2)。

工作原理

为了实现激光晶体 Nd:YAG、YAP 的 变转速生长,并达到高的转速稳定度,使用 一般的手动调速电路既达不到上述要求,又 使劳动强度增大。本仪器采用步进电机作程 序控制,调速电路加电压负反馈、电流正反 馈、电流截止负反馈等措施,从而提高转速的

· 30 ·